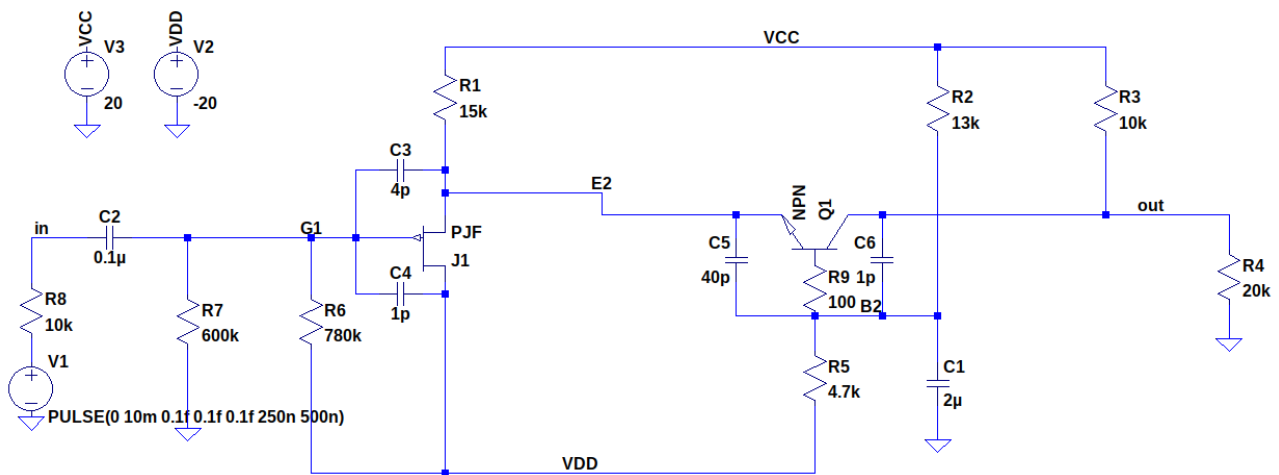


## Resultados de Simulación



### Aclaración:

La resistencia de polarización del gate se ajusta para obtener tensión de acople nula del valor teórico de 810 kOhm a 780 kOhm

### Punto de reposo:

V(out):	0.396769	voltage	Id(J1):	-0.00396375	device_current
V(b2):	-9.41202	voltage	Ig(J1):	1.28161e-011	device_current
V(e2):	-10.2034	voltage	Is(J1):	0.00396375	device_current
V(vdd):	-20	voltage	I(R8):	-8.69566e-019	device_current
V(g1):	-8.69566	voltage	I(R7):	-1.44928e-005	device_current
V(vcc):	20	voltage	I(R6):	1.44927e-005	device_current
V(in):	-8.69566e-015	voltage	I(R5):	0.00225276	device_current
V(n001):	0	voltage	I(R4):	1.98384e-005	device_current
Ic(Q1):	0.00194048	device_current	I(R3):	0.00196032	device_current
Ib(Q1):	9.70241e-006	device_current	I(R2):	0.00226246	device_current
Ie(Q1):	-0.00195019	device_current	I(R1):	0.00201356	device_current
I(C2):	-8.69566e-019	device_current	I(V3):	-0.00623635	device_current
I(C1):	-1.8824e-017	device_current	I(V2):	0.006231	device_current
			I(V1):	-8.69566e-019	device_current

### Parámetros de señal:

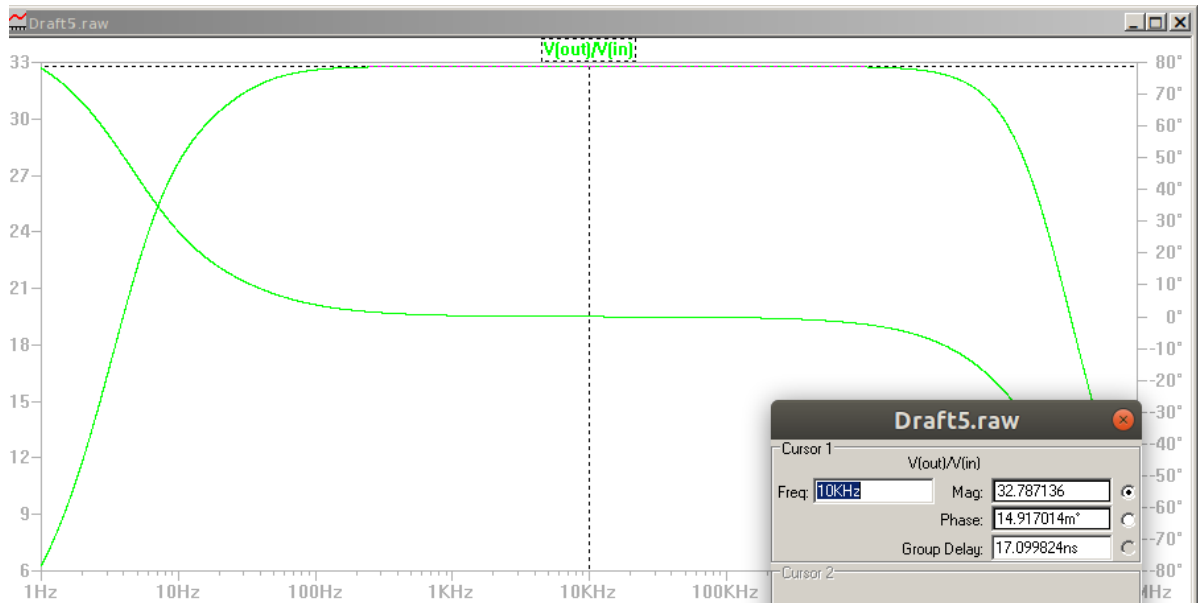
Name: q1  
Model: npn  
Ib: 9.70e-06  
Ic: 1.94e-03  
Vbe: 7.91e-01  
Vbc: -9.81e+00  
Vce: 1.06e+01  
BetaDC: 2.00e+02  
Gm: 7.50e-02  
Rpi: 2.67e+03  
Rx: 0.00e+00  
Ro: NaN  
Cbe: 0.00e+00  
Cbc: 0.00e+00  
Cjs: 0.00e+00  
BetaAC: 2.00e+02

Cbx: 0.00e+00  
Ft: 0.00e+00

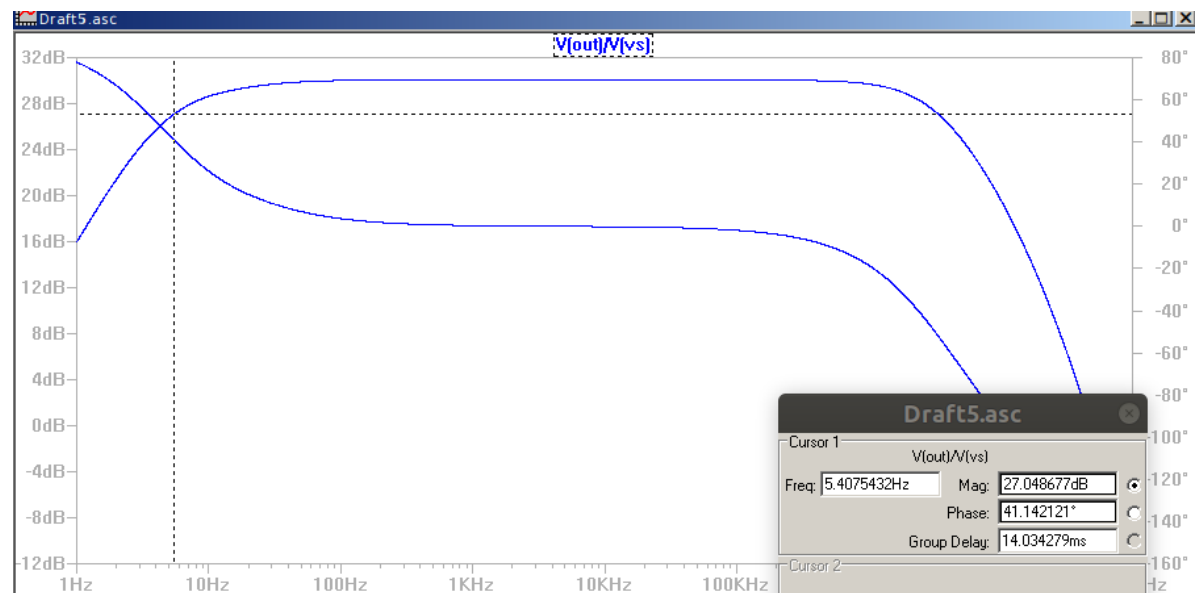
--- JFET Transistors ---

Name: j1  
Model: pjf  
Id: -3.96e-03  
Vgs: 1.51e+00  
Vds: -9.80e+00  
Gm: 5.31e-03  
Gds: 0.00e+00  
Cgs: 0.00e+00  
Cgd: 0.00e+00

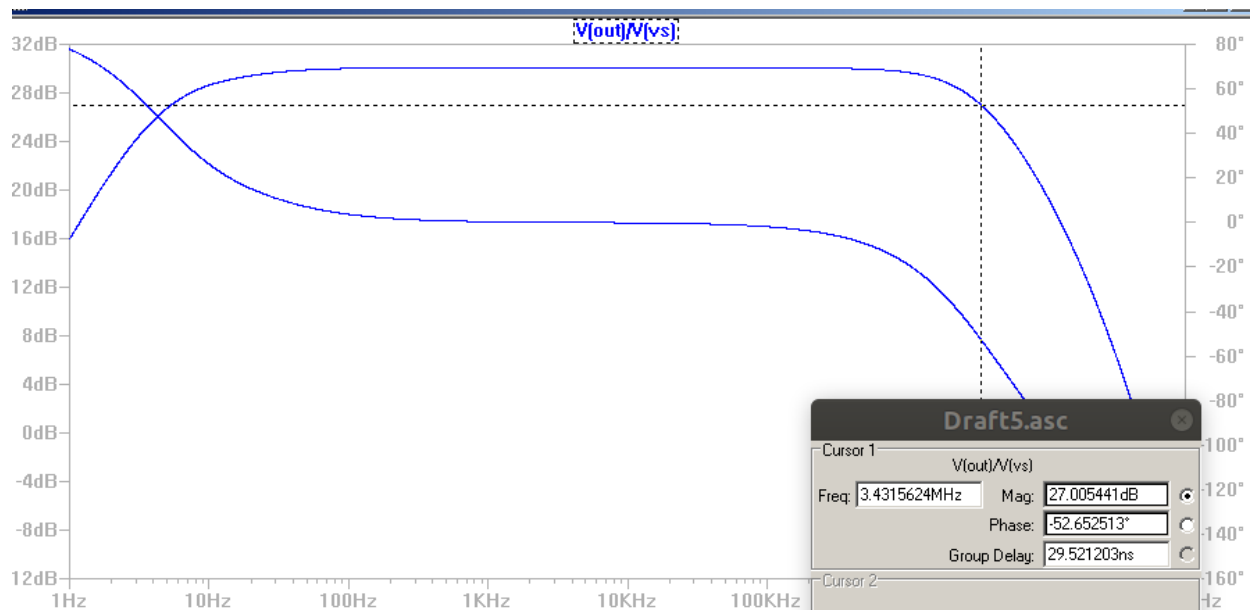
### Ganancia de tensión a frecuencias medias:



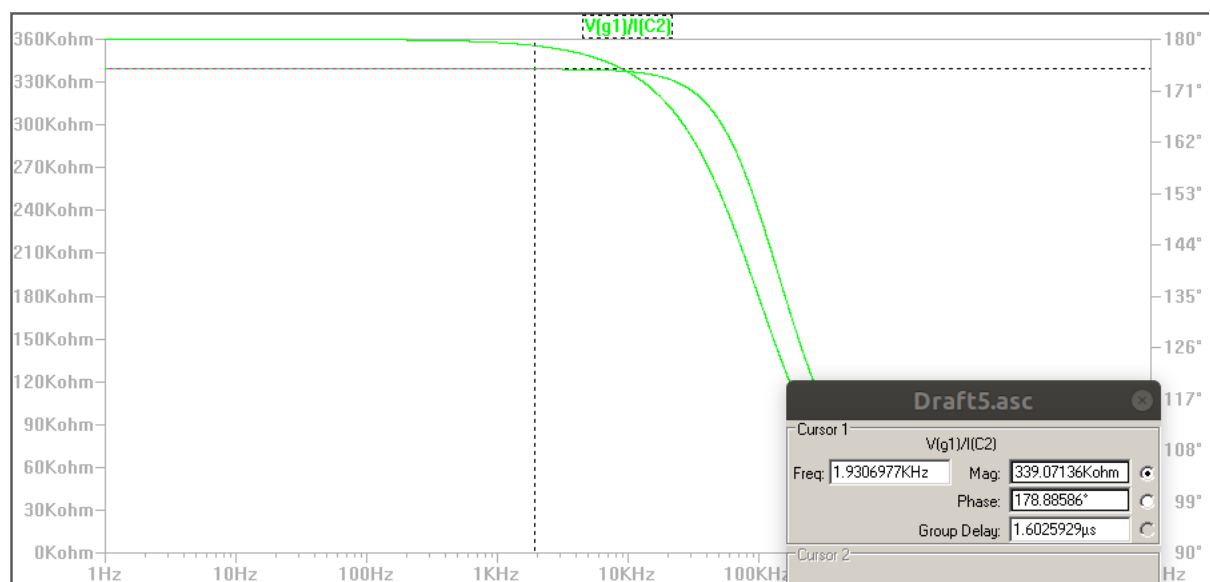
### Frecuencia de corte inferior:



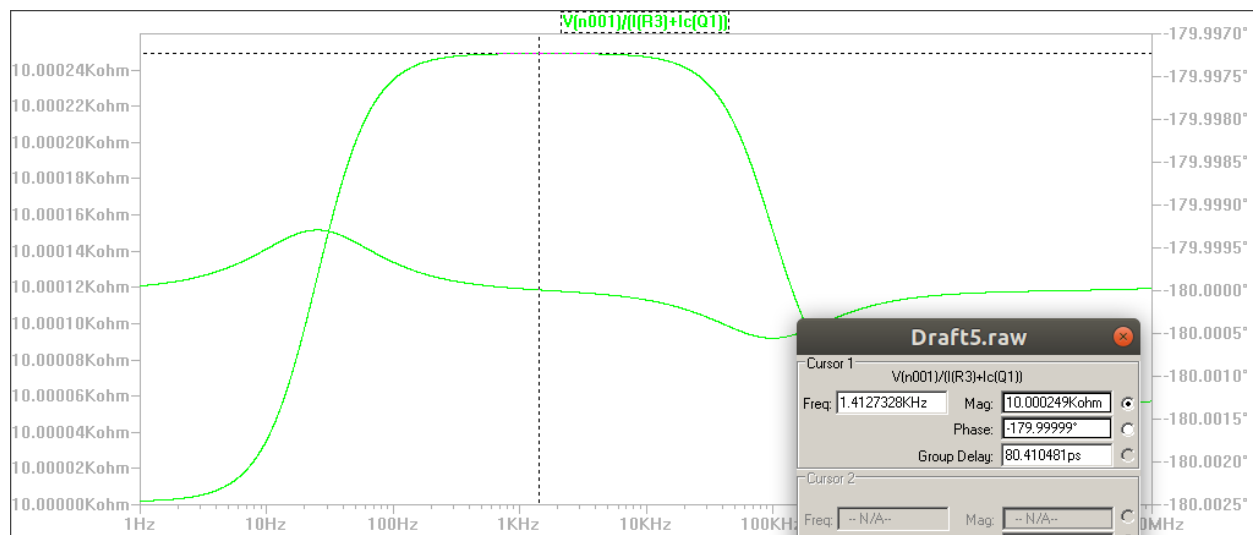
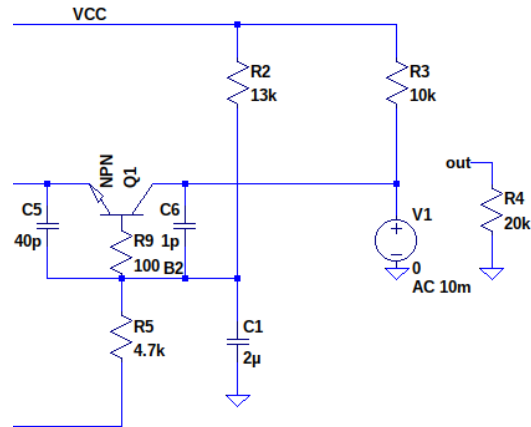
### Frecuencia de corte superior:



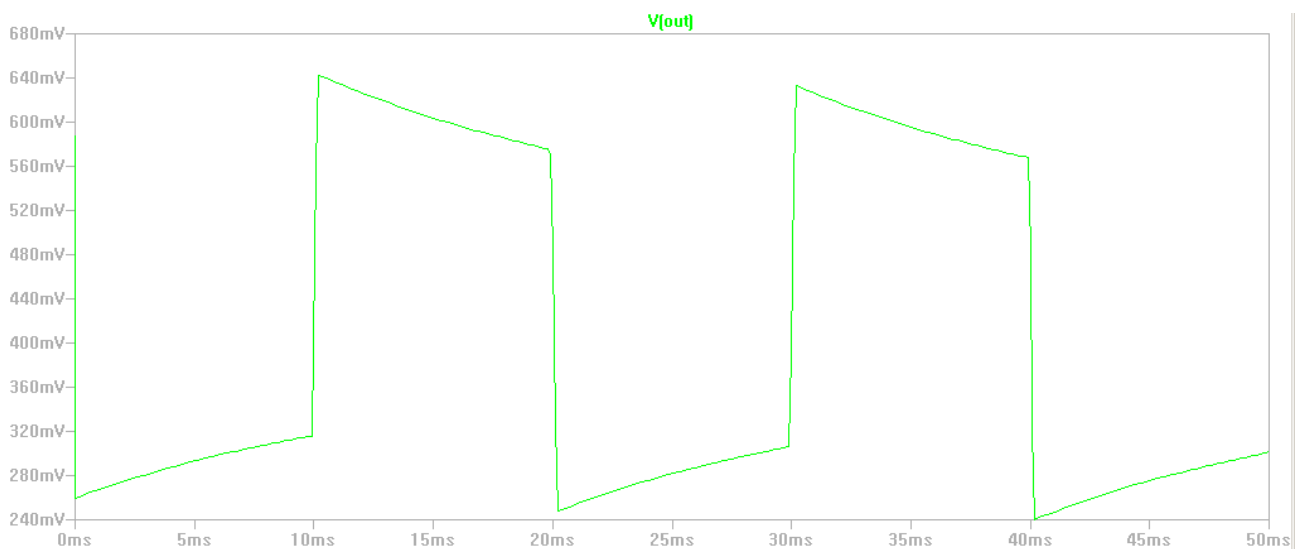
Resistencia de entrada:



Resistencia de salida:



Respuesta a tren de pulsos de frecuencia 50Hz,  $T = 20\text{ms}$ ,  $\Delta t = 10\text{ms} < 5 \cdot T_L$



Respuesta a tren de pulsos de frecuencia 1MHz

